Lösung: Selbstsperrender N-Kanal-Isolierschicht FET (MOSFET).



N- Kanal:

Die Dioden-Pfeilspitze = N zeigt zum Kanal.

Isolierschicht:

Gate und Substrat sind mit einem isolierenden Abstand voneinander gezeichnet.

Selbstsperrend:

Die unterbrochene Sperrschicht-Linie wird zur geschlossenen, wenn die Selbstsperrung im Betriebszustand eintritt. (**)

Mosfet = Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor.